

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-270929
(P2002-270929A)

(43)公開日 平成14年9月20日(2002.9.20)

(51)Int.Cl.⁷
H 0 1 S 3/098

識別記号

F I
H 0 1 S 3/098

データベース(参考)
5 F 0 7 2

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 5 頁)

(21)出願番号 特願2001-53928(P2001-53928)

(22)出願日 平成13年2月28日(2001.2.28)

(71)出願人 596092698

ルーセント テクノロジーズ インコーポ
レーテッド
アメリカ合衆国, 07974-0636 ニュージ
ャーシィ, マレイ ヒル, マウンテン ア
ヴェニュー 600

(72)発明者 フェレンク クラウツ

オーストリア国 1-2331 ヴォエセンド
ルフ, レナーガーセ 9

(74)代理人 100064447

弁理士 岡部 正夫 (外10名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 可飽和吸収体ミラーを製造するためのデジタル合金変調

(57)【要約】

【課題】 光学厚さおよび組成の望ましい変化を成し遂げ、多層スタックにおいて半導体層の遅延特性を実現するための改良された技術を提供すること。

【解決手段】 レーザをモードロックさせる際に用いられる可飽和吸収体ミラーは、なめらかなエッジフィルタを形成する誘電体層の多層スタックの下に配置された狭いエネルギーバンドギャップと広いエネルギーバンドギャップとを交互に含む化合物半導体層の多層スタックを用い、狭いエネルギーバンドギャップ層は、デジタル様式で合金変調され、ミラーが所望の群遅延分散特性を提供するようにエネルギーバンドギャップを変化させる。

